【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成31年2月21日(2019.2.21)

【公表番号】特表2017-508607(P2017-508607A)
【公表日】平成29年3月30日(2017.3.30)
【年通号数】公開・登録公報2017-013
【出願番号】特願2016-552617(P2016-552617)
【国際特許分類】
Ｂ０１Ｊ　23/18　(2006.01)
Ｂ０１Ｊ　23/22　(2006.01)
Ｃ０７Ｄ 307/89　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ０１Ｊ　23/18　Ｚ
Ｂ０１Ｊ　23/22　Ｚ
Ｃ０７Ｄ 307/89　Ｃ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成31年1月10日(2019.1.10)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ｏ－キシレンおよび／またはナフタレンをフタル酸無水物に酸化する触媒系であって、反応管内に連続して配置された複数の触媒領域を含み、少なくとも９５質量％が２００ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する、方安鉱修飾された三酸化アンチモンを使用して製造される、触媒系。
【請求項２】
少なくとも９９質量％が方安鉱修飾されている三酸化アンチモンが使用される、請求項１に記載の触媒系。
【請求項３】
方安鉱一次結晶子が二峰性または多峰性の径分布を有する、請求項１または２に記載の触媒系。
【請求項４】
方安鉱一次結晶子が１５０ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する、請求項１から３のいずれか一項に記載の触媒系。
【請求項５】
方安鉱一次結晶子が１００ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する、請求項１から３のいずれか一項に記載の触媒系。
【請求項６】
１００ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する純粋な方安鉱を使用して製造される、請求項１から５のいずれか一項に記載の触媒系。
【請求項７】
反応管内に連続して配置された複数の触媒領域を含むｏ－キシレンおよび／またはナフタレンをフタル酸無水物に酸化する触媒系の製造方法であって、三酸化アンチモンと、酸化バナジウムと、二酸化チタンとを含む触媒活性材料を、１層または複数層のシェルとして触媒担体に塗布する工程を含み、少なくとも９５質量％が２００ｎｍ未満の中央一次結

晶子径を有する、方安鉱修飾された三酸化アンチモンが使用される、方法。
【請求項８】
請求項１から６のいずれか一項に記載の触媒系を、炭化水素の気相酸化に使用する方法。
【請求項９】
請求項１から６のいずれか一項に記載の触媒系を、ｏ－キシレンおよび／またはナフタレンの炭化水素のフタル酸無水物への気体酸化に使用する方法。
【請求項１０】
ｏ－キシレンおよび／またはナフタレンのフタル酸無水物への気相酸化方法であって、少なくともｏ－キシレンおよび／またはナフタレンおよび分子状酸素を含むガス流を、反応管内に連続して配置された複数の触媒領域を含み、少なくとも９５質量％が２００ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する、方安鉱修飾された三酸化アンチモンを使用して製造された触媒系に通過させる、方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００１】
本発明は、ｏ－キシレンおよび／またはナフタレンをフタル酸無水物（ＰＡ）に酸化する触媒系であって、反応管内に連続して配置された複数の触媒領域を含み、全ての一次結晶子が２００ｎｍ未満の粒径を有する方安鉱修飾から主に成る三酸化アンチモンを使用して製造される、触媒系に関する。さらに、本発明は、少なくとも１種の炭化水素および分子状酸素を含むガス流に、反応管内に連続して配置された複数の触媒領域を含み、２００ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する方安鉱変態から主に成る三酸化アンチモンを使用して製造された触媒系を通過させる、気相酸化方法に関する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
この目的は、ｏ－キシレンおよび／またはナフタレンをフタル酸無水物に酸化する触媒系であって、反応管内に連続して配置された複数の触媒領域を含み、２００ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する、方安鉱修飾から主に成る三酸化アンチモンを使用して製造される、触媒系によって達成される。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１９】
したがって、本発明は、ｏ－キシレンおよび／またはナフタレンをフタル酸無水物に酸化する触媒系であって、反応管内に連続して配置された複数の触媒領域を含み、少なくとも９５質量％が２００ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する、方安鉱修飾である三酸化アンチモンを使用して製造される、触媒系を提供する。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２５
【訂正方法】変更

【訂正の内容】
【００２５】
本発明において使用される、小さな中央一次結晶子径を有する方安鉱修飾量が多い三酸化アンチモンは、方安鉱を多く含有する市販の三酸化アンチモン源から、当業者に公知の標準的な粉砕処理による粉末化によって得ることができる。適切な粉末化プロセスは、例えば遊星ボールミルまたはジェットミルによって行うことができる。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
したがって、本発明の別の実施形態は、反応管内に連続して配置された複数の触媒領域を含むｏ－キシレンおよび／またはナフタレンをフタル酸無水物に酸化する触媒系の製造方法であって、三酸化アンチモンと、酸化バナジウムと、二酸化チタンとを含む触媒活性材料を、１層または複数層のシェルとして触媒担体に塗布する工程を含み、少なくとも９５質量％が１５０ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する、方安鉱修飾である三酸化アンチモンが使用される、方法である。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３２】
一般的には、アナターゼ修飾の二酸化チタンが触媒活性材料に使用される。二酸化チタンは、好ましくは１５～６０m^2／ｇ、特に１５～４５m^2／ｇ、より好ましくは１３～２８m^2／ｇのＢＥＴ表面積を有する。使用される二酸化チタンは、１種の二酸化チタンまたは複数種の二酸化チタンの混合物から成ってもよい。後者の場合、ＢＥＴ表面積の値は、個々の二酸化チタンの寄与の加重平均として求められる。使用される二酸化チタンは、例えば、５～１５m^2／ｇのＢＥＴ表面積を有するTiO_2と１５～５０m^2／ｇのＢＥＴ表面積を有するTiO_2との混合物から成ることが好適である。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４３】
本発明は、少なくとも１種の炭化水素および分子状酸素を含むガス流に、少なくとも９５質量％が２００ｎｍ未満、好ましくは１５０ｎｍ未満、より好ましくは１００ｎｍ未満、さらに好ましくは５０ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する、方安鉱修飾である三酸化アンチモンを使用して製造された触媒系を通過させる、気相酸化方法をさらに提供する。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４５】
本発明の別の実施形態は、ｏ－キシレンおよび／またはナフタレンのフタル酸無水物への気相酸化方法であって、少なくともｏ－キシレンおよび／またはナフタレンおよび分子状酸素を含むガス流に、反応管内に連続して配置された複数の触媒領域を含み、少なくと

も９５質量％が２００ｎｍ未満、好ましくは１５０ｎｍ未満、より好ましくは１００ｎｍ未満、さらに好ましくは５０ｎｍ未満の中央一次結晶子径を有する、方安鉱修飾である三酸化アンチモンを使用して製造された触媒系を通過させる、方法である。